

Presseinformation

Infineon führt OptiMOS™ Fast Diode (FD)-Leistungsbauelemente mit 200V und 250V ein – optimiert für harte Kommutierungen der Body Diode

Neubiberg, 12. März 2014 – Infineon Technologies komplettiert mit den neuen OptiMOS™ FD 200V und 250V Komponenten sein Portfolio im mittleren Spannungsbereich. Die neueste Generation der Leistungs-MOSFETs ist für harte Kommutierungen der leitenden Body Diode optimiert und ermöglicht eine höhere Robustheit, geringeres Spannungs-Überschwingen sowie reduzierte Sperrerrhol-Verluste (Reverse Recovery). Das resultiert in höchster Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, insbesondere in hart schaltenden Anwendungen in Telekommunikationssystemen, industriellen Stromversorgungen, Class D-Audio-Verstärkern, Motorsteuerungen (für Systeme mit 48 bis 110 V) und DC/AC-Invertern.

Höhere Zuverlässigkeit, geringere Kosten

Die OptiMOS FD-Familie bietet eine Sperrladung (Q_{rr}), die für höchste Performance optimiert ist. So erreichen die OptiMOS FD 200V und 250V Komponenten eine Q_{rr} -Reduzierung von 40 Prozent im Vergleich zu entsprechenden Standard-OptiMOS-Versionen. Das bedeutet einen signifikanten Schritt in Richtung erhöhter Systemzuverlässigkeit durch eine Verringerung des Spannungs-Überschwingens, während die Anforderungen an eine entsprechende Schutz-Schaltung (Snubber) minimiert werden.

„Einmal mehr verschiebt Infineon die Leistungsgrenzen in der 200 und 250V-Klasse nach oben. Unser Antrieb ist es, immer wieder Maßstäbe zu setzen. Mit der neuen OptiMOS FD-Familie setzen wir den erfolgreichen Weg bei der Verbesserung der Schaltperformance fort. Dank der neuesten Generation unserer Leistungs-MOSFETs können unsere Kunden die erforderlichen Entwicklungszeiten und -kosten, insbesondere in hart schaltenden Applikationen, verringern“, sagt Richard Kuncic, Senior Director System Segment DC/DC bei Infineon Technologies.

Einfach und effizient

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFPMM201403.028d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Tillmann Geneuss
Tel.: +49 89 234-83346
tillmann.geneuss@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655,
investor.relations@infineon.com

Die neuen OptiMOS FD-Leistungsbaulemente bieten eine verbesserte Robustheit in harten Kommutierungen. Daher können sie auch unter anspruchsvolleren Bedingungen wie höheren dv/dt - und di/dt -Raten sowie in höheren Stromdichten im Vergleich zu bisher verfügbaren 200 und 250V-Technologien eingesetzt werden. Das führt außerdem zu einem vereinfachten Designprozess. Darüber hinaus verringern die OptiMOS FD-Komponenten den Durchlasswiderstand ($R_{DS(on)}$) um bis zu 45 Prozent und die Figure of Merit (FOM) um bis zu 65 Prozent im Vergleich zu alternativen Bauelementen. Damit bieten sie den höchsten Wirkungsgrad und die höchste Leistungsdichte.

Portfolio und Verfügbarkeit

Das OptiMOS FD 200V-Portfolio beinhaltet Varianten im D²PAK-Gehäuse mit einem $R_{DS(on)}$ von 11,7 m Ω und im TO-220-Gehäuse mit einem $R_{DS(on)}$ von 12 m Ω . Das OptiMOS FD 250V-Portfolio besteht aus einer TO-220-Ausführung mit einem $R_{DS(on)}$ von 22 m Ω .

Samples sind in beiden Spannungsklassen und in allen Gehäusen verfügbar.

Weitere Informationen zu den neuen OptiMOS Fast Diode 200V und 250V-Familien stehen zur Verfügung unter: www.infineon.com/optimosFD

Über Infineon

Die [Infineon](http://www.infineon.com) Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: [Energieeffizienz](#), [Mobilität](#) sowie [Sicherheit](#). Mit weltweit rund 26.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2013 (Ende September) einen Umsatz von 3,84 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com

Diese Presseinformation finden Sie unter www.infineon.com/presse.